











中华人民共和国科学技术部 Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

请输入关键字 搜索 全站

公众参与 组织机构 信息公开 科技政策 党建工作 专题专栏 首页 政务服务

当前位置: 科技部门户 > 科技动态

www.most.gov.cn

国外研究表明手性磁体材料可提高类脑计算适应性

日期: 2023年12月13日 17:56 来源: 科技部合作司 【字号: 大中小】

英国伦敦大学学院、伦敦帝国理工学院领导的国际合作研究表明,利用手性(扭曲)磁体的内在物理特性,可提高机器学习任务适 应性,大幅减少类脑计算的能源使用。研究结果发表在《自然·材料》杂志上。

传统计算由于独立的数据存储和处理单元需要消耗大量电力。机器学习利用物理储层计算方法,消除对独特内存和处理单元的需 求,促进更有效的数据处理方式,成为传统计算更可持续的替代方案。但该方法的缺陷在于缺乏可重新配置性,执行不同计算任务时效 果存在差异,这是由材料物理特性导致的。

科研团队使用手性(扭曲)磁体作为计算介质,利用矢量网络分析仪确定其在不同磁场强度和-269°C到室温范围内温度下的能量吸 收。研究发现,通过施加外部磁场和改变温度,可以调整这些材料的物理特性以适应不同的机器学习任务,不同磁相对不同类型计算任 务具有像人脑一样好的执行效果。

本文摘自国外相关研究报道,文章内容不代表本网站观点和立场,仅供参考。











版权所有:中华人民共和国科学技术部

办公地址:北京市海淀区复兴路乙15号 | 联系我们

邮政地址:北京市海淀区复兴路乙15号 | 邮政编码: 100862

ICP备案序号: 京ICP备05022684 | 网站标识码: bm06000001 | 建议使用IE9.0以上浏览器或兼容浏览器